

### **HER101 - HER108**

## 1 амперный высокоэффективный диод

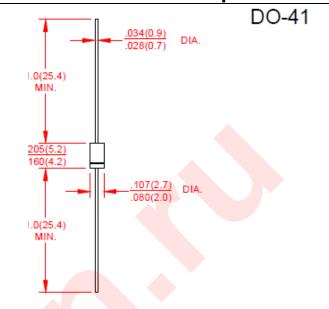
# диапазон напряжения от 50 до 1000 вольт ток 1 ампер

#### ОСОБЕННОСТИ:

- Низкое прямое падение напряжения
- Номинальное напряжение до 1000В
- Высокая допустимая нагрузка по току
- Высокая надежность
- Высокая перегрузочная способность
- Высокая температура пайки, гарантированно: 260°C в течение 10 секунд

#### Механические данные

- Корпус: литой пластиковый корпус DO-41
- Пластиковые материалы UL классификация воспламеняемости 94 V-0
- Вывода: аксиальные вывода, пайка в MIL-STD-202E, методика 208C
- Полярность: цветовое кольцо обозначает катод
- Монтажное положение: любое
- Вес: 0,33 грамма



Размеры в дюймах и (мм)

#### МАКСИМАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Значения параметров при 25°С температуре окружающей среды, если не указано иное.

Однофазный, напряжение (B) половина волны, частота – 60 Гц, для резистивных и индуктивных нагрузок.

Для емкостной нагрузки уменьшайте ток на 20%

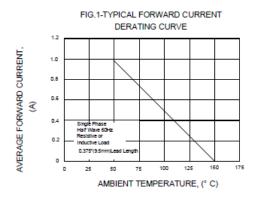
HATTI CINKOCTTON HAI PYSKIT YMETIBEENTE TOK HA 20	/0									
ПИТ		HER101	HER102	HER103	HER104	HER105	HER106	HER107	HER108	Едини ца измер ения
Максимальное пиковое импульсное обратное напряжение	VRRM	50	100	200	300	400	600	800	1000	В
Максимальное среднеквадратическое значение напряжения	VRMS	35	70	140	210	280	420	560	700	В
Максимальное постоянное запирающее напряжение	VDC	50	100	200	300	400	600	800	1000	В
Максимальный средний прямой выпрямленный ток Т = 50°C	lF(AV)	1.0								А
Максимальный прямой ток и <mark>мпу</mark> льса в течении 8.3 мсек. (JEDEC метод)	IFSM	30								Α
Максимальное па <mark>дение напряжения на отк</mark> рытом диоде при прямо <mark>м токе 1</mark> А	VF	1.0 1.3 1.5				1	.7	В		
Максимальный по <mark>стоянн</mark> ый обр <mark>атны</mark> й ток при номинальном постоян <mark>ном о</mark> братном напряжении T <sub>J</sub> = 25°C T <sub>J</sub> = 125°C	lR	5 250								мкА
Типичное время обратного восстановления (Примечание 2)	Trr	50 75						нсек.		
Типичная емкость перехода, на выводах (Примечание 1)	Cì	15			12				пФ	
Диапазон рабочих температур	TJ	-55 до +150							"C	
Диапазон температур хранения	Tstg	-55 до +150								°C

Примечание: 1. Измеряется на частоте 1.0 МГЦ и обратном постоянном напряжении 4,0 В.

2. Обратное восстановление, условия тестирования: IF = 0.5A, IR = 1.0A, IRR = 0.25A.

#### ГРАФИКИ ХАРАКТЕРИСТИК **HER101 - HER108**





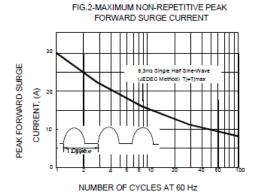
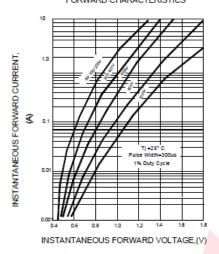


FIG.3-TYPICAL INSTANTANEOUS FORWARD CHARACTERISTICS



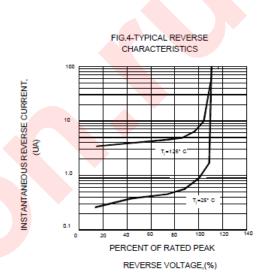
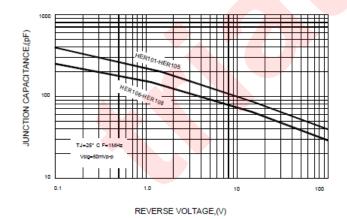


FIG 6 TEST CIRCUIT DIAGRAVIANO REVERSE REXOUERY TIINS CHRACTERISTIC

#### FIG.5-TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE



NOTE: 1.Rise Time =7ns max.input impedance=1megohm.22pF 2.Rise time=10ns max.Source impedance=50 ohms

